



NTE387: Transistor Bipolar NPN 150v 50A



Descripción

Nombre: TRANSISTOR BIPOLAR NPN 150V 50A **Referencia:** NTE387

- Polaridad del transistor: NPN
- Configuración: Single
- Corriente CC máxima de colector: 50A
- Máx. voltaje VCEO colector-emisor: 150 V
- Tensión VCBO colector-base: 180 V
- Voltaje VEBO emisor-base: 6 V
- Voltaje de saturación colector-emisor: 3V @IC = 50A, IB = 10A
- Dp - Disipación de potencia: 250 W @ (TC = +25°C)
- Temperatura de trabajo: desde - 55 C hasta + 150 C

Marca: NTE ELECTRONICS **Empaque:** TO-3 **Precio por:** Unidad **Ficha técnica:** [NTE387](#)

Información del producto

Descripción: TRANSISTOR BIPOLAR NPN 150V 50A NTE ELECTRONICS Referencia: NTE387
El NTE387 es un transistor bipolar NPN de silicio, diseñado para aplicaciones de alta potencia. Esto significa que puede manejar corrientes eléctricas significativas y voltajes elevados. Se utiliza comúnmente en circuitos donde se requiere amplificar señales, conmutar cargas o actuar como un interruptor controlado.

Precio: \$162.744 IVA INCLUIDO

SKU: 9-5-133

Categorías: [SEMICONDUCTORES](#), [TRANSISTORES Y REGULADORES](#)

Etiquetas: [0090005000133](#), [9-5-133](#), [datasheet](#), [NTE ELECTRONICS](#), [NTE387](#), [pinout](#), [SEMICONDUCTORES](#), [Through Hole](#), [TRANSISTOR BIPOLAR NPN 150V 50A](#), [TRANSISTORES Y REGULADORES](#)



NTE387
Silicon NPN Transistor
Power Area, Switch

Features:

- High Collector-Emitter Sustaining Voltage
- High DC Current Gain
- Low Collector-Emitter Saturation Voltage
- Fast Switching Times

Absolute Maximum Ratings:

Collector-Emitter Voltage, V _{CE}	150V
Collector-Base Voltage, V _{CB}	180V
Emitter-Base Voltage, V _{EB}	6V
Collector Current, I _C	50A
Base Current, I _B	10A
Collector-Emitter Saturation Voltage, V _{CE(sat)}	3V
Operating Junction Temperature, T _J	-55 to +150°C
Storage Temperature Range, T _{stg}	-55 to +150°C
Thermal Resistance, Junction-to-Case, R _{θJC}	0.2°C/W

Note 1: Matched pairs are available upon request (NTE387MP). Matched pairs have their gain listed in the table below.

Parameter	Symbol	Test Conditions	Min	Typ	Max
Collector-Emitter Sustaining Voltage	V _{CE}	I _C = 50A, I _B = 10A, V _{CB} = 0V	150	—	—
Collector-Base Voltage	V _{CB}	I _C = 50A, I _B = 10A, V _{CE} = 0V	180	—	—
Emitter-Base Voltage	V _{EB}	I _C = 50A, I _B = 10A, V _{CE} = 0V	6	—	—
Collector Current	I _C	V _{CE} = 150V, V _{CB} = 0V, V _{EB} = 0V, f = 100Hz	—	50	—
Base Current	I _B	V _{CE} = 150V, V _{CB} = 0V, V _{EB} = 0V, f = 100Hz	—	10	—
Collector-Emitter Saturation Voltage	V _{CE(sat)}	I _C = 50A, I _B = 10A, V _{CB} = 0V, V _{EB} = 0V, f = 100Hz	—	3	—
Operating Junction Temperature	T _J	—	-55	—	+150
Storage Temperature Range	T _{stg}	—	-55	—	+150

Note 2: Pulse Test: Pulse Width < 200µs, Duty Cycle < 2%.